

Description

Réalisé en scellement verre-métal, ce boîtier fond cuivre à haute conductibilité thermique est essentiellement destiné à l'encapsulation hermétique des transistors et thyristors de puissance...

Caractéristiques

- **Cadre** acier et fond cuivre allié, assemblage par brasure dure.
- **Broches**: ferro-nickel avec âme cuivre.
- **Finition**: — nickel chimique
— dorure totale ou dorure sélective des broches sur sous couche nickel...
- **Température maximale**: 400°C
- **Tension de tenue**: 700 V crête
- **Courant maximal admissible**:
— en continu : 10 A
— impulsions : 15 A
- **Résistance d'isolement**: 10⁴ MΩ
- **Résistance thermique** typique jonction-boîtier (°C/W) :

dimensions puces (mm ²)	10	25	50
report par brasure	0,70	0,28	0,14

Description

In glass to metal seal this high thermal conductivity package with copper base is especially designed for hermetic encapsulation of power transistors and thyristors...

Characteristics

- **Steel frame** and alloy copper base, hard brazing assembly.
- **Pins**: nickel-iron with copper core.
- **Finishing**: — electroless nickel plating
— full or selective gold plating on pins over nickel underplating...
- **Maximum operating temperature**: 400°C
- **Dielectric withstanding voltage**: 700 V peak
- **Maximum input current**:
— direct current : 10 A
— pulses : 15 A
- **Insulation resistance**: 10⁴ MΩ
- **Typical junction-base thermal resistance** (°C/W) :

chip sizes (mm ²)	10	25	50
brazing mounting	0,70	0,28	0,14

